Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0523U100214

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-10-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Олійник Сергій Володимирович
2. Serhii V. Oliinyk

Кваліфікація: к. т. н., доцент, 05.27.06

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6073-8531

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 30-11-2023

Спеціальність за освітою: Виробництво електронних засобів

Місце роботи здобувача: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 35.052.13

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, буд. 12, Львів, 79013, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 29.19

Тема дисертації:

1. Фізичні основи формування електричних та фотоелектричних властивостей кристалів AIIBVI і електричних властивостей багатокомпонентних покриттів

2. Physical basis of formation of electrical and photoelectric properties of AIIBVI crystals and electrical properties of multicomponent coatings

Реферат:

1. Дисертація присвячена проблемі розроблення фізичних основ формування електричних та фотоелектричних властивостей високоомних кристалів AIIBVI, а також електричних властивостей покриттів WC і високоентропійного сплаву Ti-V-Zr-Nb-Hf. Розроблено комплекс нових методів дослідження, що охоплюють різні складові технологій приготування високоомних кристалів, серед яких метод вимірювання питомого електроопору з урахуванням діелектричної дисперсії, енергетичного спектра локалізованих станів носіїв заряду для окремих зразків та методи визначення розподілу електрофізичних параметрів в межах усього кристалічного зливку. Встановлено та надано пояснення закономірним змінам дійсної та уявної частин низькочастотної діелектричної проникності в межах усього об’єму кристалічних зливків Cd1-xZnxTe та ZnSe. Дані закономірності запропоновано використовувати для визначення експлуатаційної стабільності

характеристик сенсорів іонізуючого випромінювання, виготовлених із зливків Cd1-xZnxTe та ZnSe. Вперше встановлено, що введення в кристали ZnSe легуючих атомів Cr з концентрацією 1018 см-3 суттєво покращує діелектричні характеристики цих матеріалів, зокрема покращує просторову однорідність складових низькочастотної діелектричної проникності при одночасному зниженню рівня дисипації енергії поля на ≈ (80 – 90)%. Показано, що легування кристалів CdWO4 атомами Bi (10-3 мас.%) так само як і високотемпературний відпал в водневій атмосфері зумовлює збільшення їх діелектричної проникності в 15 разів і коефіцієнта діелектричних втрат в (40 – 500) разів в низькочастотній області. Отримано та досліджено нові перспективні для оптоелектроніки композитні матеріали на основі кристалів AIIBVI, електрофізичні та фотоелектричні властивості яких визначаються приповерхневими локалізованими станами носіїв заряду кристалітів. Вперше встановлена стабілізація дійсної та уявної частин діелектричної проникності кристалів Cd1-xZnxTe в низькочастотній області під впливом ультрамалих експозиційних доз гама-випромінювання (10 – 40 Р). Експериментально показано чутливість комплексної діелектричної проникності кристалів типу Cd1-xZnxTe до гама-випромінювання з дуже малою експозиційною потужністю дози 700 мкР/годину. Останнє пояснено наявністю суттєво нерівноважного стану власних дефектів структури внаслідок відхилення складу від стехіометричного при зрозстанні з розплаву кристалів Cd1-xZnxTe. Вперше встановлена кореляція макроскопічної неоднорідності електрофізичних властивостей нітридних покриттів на основі високоентропійного сплаву Ti-V-Zr-Nb-Hf з щільністю включень, які виникли при формуванні покриттів. Усунення фізико-технологічних факторів формування таких включень необхідне для формування однорідних за електричними властивостями нітридних покриттів на основі високоентропійного сплаву Ti-V-Zr-Nb-Hf. Виявлено кореляційний зв'язок мікротвердості зі сталою кристалічної решітки та областю когерентного розсіювання рентгенівських промінів багатокомпонентних покриттів на основі WC. Це можна використовувати для цілеспрямованого покращення механічних властивостей і керованої зміни електричних властивостей зазначених покриттів шляхом оптимізації їхнього складу та умов формування.

2. The dissertation is devoted to the problem of developing the physical foundations of the formation of the electrical and photoelectric properties of high-resistance AIIBVI crystals, as well as the electrical properties of WC coatings and the high-entropy Ti-V-Zr-Nb-Hf alloy. The complex of new methods of research of electrophysical and photoelectric properties of high-resistance crystals has been developed. The regular changes in the low-frequency complex permittivity in Cd1-xZnxTe and ZnSe crystalline ingots were established and explained. The regularities of the effect of doping Cr (1018 cm-3) and Bi (10-3 wt. %) on the electrophysical properties of ZnSe and CdWO4 crystals, respectively, were established. New composite materials based on AIIBVI crystals were obtained and studied. For the first time, the stabilization of of Cd1-xZnxTe crystals in the low-frequency region under the influence of ultra-small exposure doses of gamma radiation (10 – 40 R) was established, and their sensitivity of to gamma radiation (700 μR/hour) was experimentally discovered and explained. For the first time, a correlation between the macroscopic heterogeneity of electrophysical properties and the density of growth inclusions of Ti-V-Zr-Nb-Hf coatings was established. The correlation between microhardness, crystal lattice constant and the region of coherent scattering of WC coatings was revealed.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- 1. Chugai O.O., Poluboiarov O.O., Oleynick S.V., Sulima S.V., Voloshin O.O., Zaitsev R.V., Kirichenko M.V. Scanning photodielectric spectroscopy of CdZnTe crystals under additional non-monochromatic illumination. – Sensors and Actuators, A: Physical. – 2021. – V. 328. – Article 112772.
- 2. Poluboiarov O.O., Chugai O.N., Oleynick S.V., Sulima S.V. Dielectric properties and quality of Cd1-XZnXTe crystals for gamma radiation detectors. – Sensors and Actuators A: Physical. – 2016. – V. 244. – P. 233 – 236.
- 3. Horban V.F., Serdiuk I.V., Chuhai O.M., Voloshyn O.O., Oliinyk S.V., Veselivska H.H., Danylenko M.I., Sliusar D.V., Stolbovyi V.A., Kalahan O.S. Specific Features of the Structure and Electrophysical Characteristics of Nitride Coatings Based on Ti–V–Zr–Nb–Hf High-Entropy Alloy. – Materials Science. – 2021. – V.57, no. 3. – P. 428 – 433.
- 4. Kolesnyk V.P., Chuhai O.M., Kalakhan O.S., Voloshyn O.O., Oleinyk S.V., Veselivs'ka H.H. Structure and Properties of Ionic-Plasma WC Coatings. – Materials Science. – 2019 – V.55, no.2. – P. 220 – 224.
- 5. Chugai O.M., Gerasimenko A.S., Komar' V.K., Nalivaiko D.P., Oleinik S.V., Podshivalova O.V., Sulima S.V., Novokhatskaya T.N. Effect of dopant Cr ions on the dielectric properties of melt-grown ZnSe crystals. – Physics of the Solid State. – 2013. – V. 55. – P. 60 – 63.
- 6. Abashin S.L., Komar V.K., Nalyvaiko D.P., Oleynick S.V., Puzikov V.M., Rom M.A., Sulima S.V., Chugai O.N. Influence of dielectric relaxation on the contactless resistivity measurement of semiinsulating CdZnTe crystals. – Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika). – 2011. – V. 70, No 13. – P. 1203 – 1215.
- 7. Komar V.K., Sulima S.V., Chugai O.M., Abashin S.L., Nikolov O.T., Oleinik S.V., Puzikov V.M., Terzin I.S., Yatsina Y.A. Effect of ionizing radiation in ultrasmall doses on dielectric properties of CdZnTe crystals with anomalously high polarizability. – Technical Physics Letters. – 2011. – V. 37. – P. 589 – 592.
- 8. Chugai O.M., Gerasimenko A.S., Komar' V.K., Morozov D.S., Oleinik S.V., Puzikov V.M., Rizak I.M., Sulima S.V. Dielectric properties of ZnSe crystals grown from melt. – Physics of the Solid State. – 2010. – V. 52. – P. 2467 – 2471.
- 9. Poluboiarov O., Chugai O., Oliinyk S., Sliusar D., Sulima S. Effect of low-dose-rate ionizing radiation on the complex dielectric permittivity of CdZnTe crystals. – Lithuanian journal of physics. – 2023. – V. 63, no. 1. – P. 35 – 39.
- 10. Slusar D., Isakov O., Kolesnyk V., Chugai O., Oliynick S. Computer Simulation of Abnormal Glow Discharge in Inverse Magnetron Sputtering Systems with Sectioned Cathode Units. – Springer, Cham, 2021, October. – P. 311 – 320.
- 11. Chugai O.M., Oleynick S.V., Voloshin O.O., Galkin S.M., Sidelnikova L.Iu., Sosnytska O.O. Influence of Electromagnetic Radiation of Different Quantum Energy on Dielectric Properties of Composites Based on Crystals CdZnTe and ZnSe. – Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – V. 1113. – P. 139 – 150.
- 12. Chugai O.M., Tupitsyna I.A., Oleynick S.V., Voloshin O.O., Luniov I.V. Influence of Bi doping and high-temperature annealing on optical and dielectric properties of CdWO4 crystals. – Functional Materials. – 2020. – V. 27, № 2. – P. 245 – 251.
- 13. Poluboiarov O.O., Chugai O.N., Voloshin O.O., Zherebyatiev D.P., Oleynick S.V., Sulima S.V. Inhomogeneity of dielectric properties of cadmium zinc-telluride crystals grown from melt. – Functional materials. – 2016. – V. 23, № 3. – P. 378 – 381.
- 14. Литовченко Л.В., Колесник В.П., Чугай О.М., Бояркін А.О., Слюсар Д.В., Степанушкін М.П., Олійник С.В. Особливості побудови системи електроживлення інверсної магнетронної розпорошувальної системи для формування багатокомпонентних покриттів (спосіб управління процесом розпорошення та його практична реалізація) – Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2019. – № 2 (90). – С. 99 – 107.
- 15. Чугай О.М., Абашин С.Л., Олійник С.В., Луньов І.В. Вплив механічної обробки поверхні на діелектричні та фотодіелектричні властивості кристалів AIIBVI. – Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2021. – №3. – С. 73 – 78.
- 16. Чугай О.М., Полубояров О.О., Олійник С.В., Волошин О.О., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В. Макроскопічна неоднорідність оптичних, діелектричних і фотодіелектричних властивостей кристалів ZnSe. –

Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2020. – № 6(166). – С. 54 – 60.
- 17. Слюсар Д.В., Колесник В.П., Чугай О.М., Литовченко Л.В., Іщенко Є.І., Олійник С.В. Вплив попередньої підготовки поверхні підкладок на морфологію двокомпонентних покриттів, отриманих в інверсній магнетронній розпорошувальній системі. – Авіаційно-космічна техніка та технологія. – 2019. – № 1 (153). – С. 79 – 85.
- 18. Литовченко Л.В., Колесник В.П., Чугай О.М., Бояркін А.О., Слюсар Д.В., Степанушкін М.П., Олійник С.В. Особливості побудови систем електроживлення інверсної магнетронної розпорошувальної системи для формування багатокомпонентних покриттів (практичні аспекти розробки резистивних ланцюжків у складі генератора плазми). – Авіаційно-космічна техніка та технологія. – 2019. – № 5 (157). – С. 12 – 23.
- 19. Слюсарь Д.В., Колесник В.П., Чугай О.Н., Литовченко Л.В., Степанушкин Н.П., Абашин С.Л., Олейник С.В. Вплив різних факторів на морфологію поверхні покриттів типу WC, що осаджені іонно-плазмовим методом. – Авіаційно-космічна техніка та технологія. – 2018. – № 6 (150). – С. 76 – 82.
- 20. Чугай О.М., Олійник С.В., Колесник В.П., Полубояров О.О., Слюсар Д.В., Сулима С.В., Волошин О.О. Діелектричні, оптичні та фотоелектричні властивості кристалів AIIBVI, вирощених з розплаву: монографія. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 191 с.
- 21. Чугай О.М., Терзін І.С., Комар В.К., Новохатська Т.М., Полубояров О.О., Сулима С.В., Олійник С.В., Шматко О.О. Спосіб вимірювання питомого електроопору високоомних твердих розчинів напівпровідників: пат. на винахід № 76300 Україна МПК (2012) G01R 31/26; заявник й патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського „Харк. авіац. ін.-т”; Заявл. 09.07.2012; Опубл. 25.10.2012, Бюл. №24. – 8 с.
- 22. Чугай О.М., Комар В.К., Сулима С.В., Пузіков В.М., Герасименко А.С., Абашин С.Л., Олійник С.В., Морозов Д.С. Спосіб вимірювання питомого електроопору високоомних твердих розчинів напівпровідників: пат. на винахід №90037 Україна, МПК G01R 31/26; заявник і патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т»; Заявл. 17.06.2008; Опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6. – 6 с.
- 23. Чугай О.М., Абашин С.Л., Герасименко А.С., Комар В.К., Новохатська Т.М., Полубояров О.О., Олійник С.В., Сулима С.В. Спосіб визначення фотоактивних центрів в кристалічних матеріалах: пат. на винахід №78882 Україна, МПК (2012) G01N 13/00; заявник і патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського „Харк. авіац. ін.-т”. – № u2012 08435; Заявл. 09.07.2012; Опубл. 10.04.2013, Бюл. №7. – 6 с.
- 24. Галкін С.М., Рибалка І.А., Сосницька О.О., Волошин О.О., Чугай О.М., Олійник С.В. Спосіб визначення розподілу електрофізичних неоднорідностей в кристалічному матеріалі: пат. на винахід № 123325 Україна МПК G01J 5/50 (2006.01) та G01N 27/22 (2006.01); заявники й патентовласники Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної Академії Наук України і Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; Заявл. 21.12.2018; Опубл. 17.03.2021, Бюл. №11. – 8 с.
- 25. Чугай О.М., Абашин С.Л., Пузіков В.М., Комар В.К., Олійник С.В., Сулима С.В. Спосіб визначення розподілу електрофізичних неоднорідностей в кристалічних матеріалах: пат. на винахід № 92595 Україна МПК G01J 5/50, G01N 27/22; заявник й патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського „Харк. авіац. ін.-т”; Заявл. 20.06.2007; Опубл. 25.11.2010. – 6 с.
- 26. Чугай О.М, Терзін І.С., Комар В.К., Охрімовський А.М., Олійник С.В., Полубояров О.О., Сулима С.В., Яцина Ю.А. Спосіб вимірювання експозиційної дози електромагнітного випромінювання: пат. на винахід № 76301 Україна МПК (2012) G01T 1/24; заявник й патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського „Харк. авіац. ін.-т”; Заявл. 09.07.2012; Опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. – 8 с.
- 27. Чугай О.М., Полубояров О.О., Олійник С.В., Волошин О.О., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В. Макроскопічна неоднорідність оптичних, діелектричних і фотодіелектричних властивостей кристалів ZnSe. Міжнародна науково-практична конференція “Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering” ICTM-2020: тези доп. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. –С. 21 – 25.

- 28. Чугай О.М., Волошин О.О., Олійник С.В., Галкін С.М., Сідельнікова Л.Ю., Сосницька О.О. Дослідження впливу електромагнітного випромінювання з різною енергією квантів на діелектричні властивості композитів на основі кристалів CdZnTe і ZnSe. Міжнародна науково-практична конференція “Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering” ICTM-2019 («Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» ІКТМ-2019): Тези доп. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – Том 2. –С. 147 – 150.
- 29. Chugai O.N., Gavrishuk E.M., Balabanov S.S., Oleynick S.V. et. al. Effect of alloying chromium atoms on the defect structure and electrical properties of polycrystalline zinc selenide grown by CVD-method. Abstr. of Int. Conf. “Functional Materials” ICFM – 2011. – Partenit, Crimea, Ukraine, October 3 – 8. – 2011. – P. 153.
- 30. Komar V.K., Abashin S.L., Chugai O.N., Oleynick S.V. et. al. Composition Irregularities and Electrophysical Properties of Melt-Grown CdZnTe Crystals. Int. Conf. on Crystal Growth (ICCG-16) in conjunction with The 14th International Conference on Vapor Growth and Epitaxy (ICVGE-14). – Beijing, China, August 8 – 13. – 2010.
- 31. Gerasimenko A.S., Komar V.K., Morozov D.S., Oleynick S.V. et. al. The influence of Cr alloying atoms on dielectric properties of ZnSe laser crystals. Abstr. Of Int. Conf. “Functional Materials” ICFM – 2009. – Partenit, Crimea, Ukraine, October 5 – 10. – 2009. – P. 341.

Наукова (науково-технічна) продукція: матеріали; методи, теорії, гіпотези

Соціально-економічна спрямованість: створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0110U008144; 0115U004883; 0118U003840; 0117U005435; 0121U112197

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чугай Олег Миколайович

2. Oleh M. Chuhai

Кваліфікація: д.т.н., професор, 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хрипунов Геннадій Семенович

2. Hennadii S. Khrypunov

Кваліфікація: д.т.н., професор, 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02071180

Місцезнаходження: вул. Кирпичова, буд. 2, Харків, Харківський р-н., 61002, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Литвиненко Володимир Вікторович

2. Volodymyr V. Lytvynenko

Кваліфікація: д. т. н., с.н.с., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 14351499

Місцезнаходження: вул. Гуданова, 13, Харків, Харківський р-н., 61002, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Малинич Сергій Захарович

2. Serhiy Z. Malynych

Кваліфікація: д. ф.-м. н., професор, 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Код за ЄДРПОУ: 08410370

Місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, буд. 32, Львів, 79012, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство оборони України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Баранов Олег Олегович
2. Oleh O. Baranov

Кваліфікація: д. т. н., професор, 05.03.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Таран Анатолій Олексійович
2. Anatoliy O. Taran

Кваліфікація: д.т.н., професор, 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кислицин Олександр Петрович

2. Oleksandr P. Kyslytsyn

Кваліфікація: д. т. н., професор, 05.03.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 17, Харків, Харківський р-н., 61070, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Убізський Сергій Борисович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Убізський Сергій Борисович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Клим Галина Іванівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна